

SJT0281 NPN型硅三极管

描述

SJT0281NPN 是 NPN 型硅三极管采用士兰微电子平面三极管工艺技术制造。

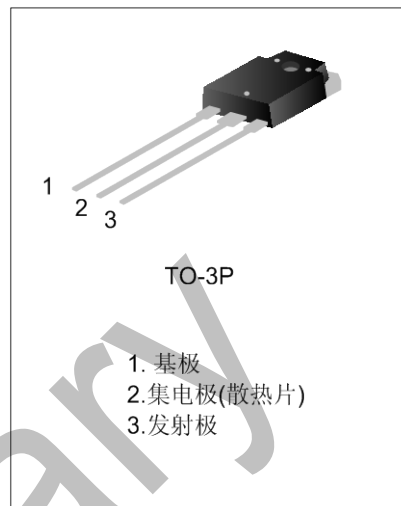
该产品主要应用在 150W 高保真音频放大输出。

SJT0281NPN 三极管目前可提供 TO-3P 封装外形。

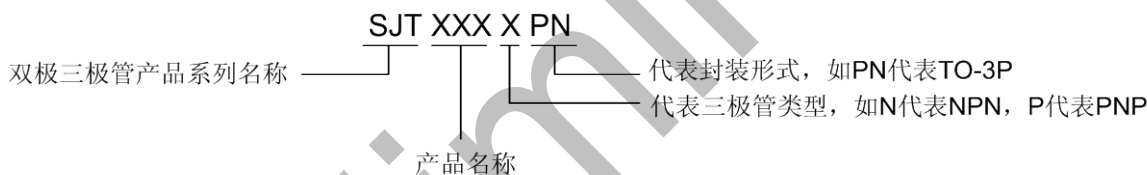
互补 PNP 管：SJT0302PPN。

特点

- 较高的击穿电压。
- 很小的漏电电流。



产品命名规则



产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	材料	包装
SJT0281NPN	TO-3P	0281	无铅	料管

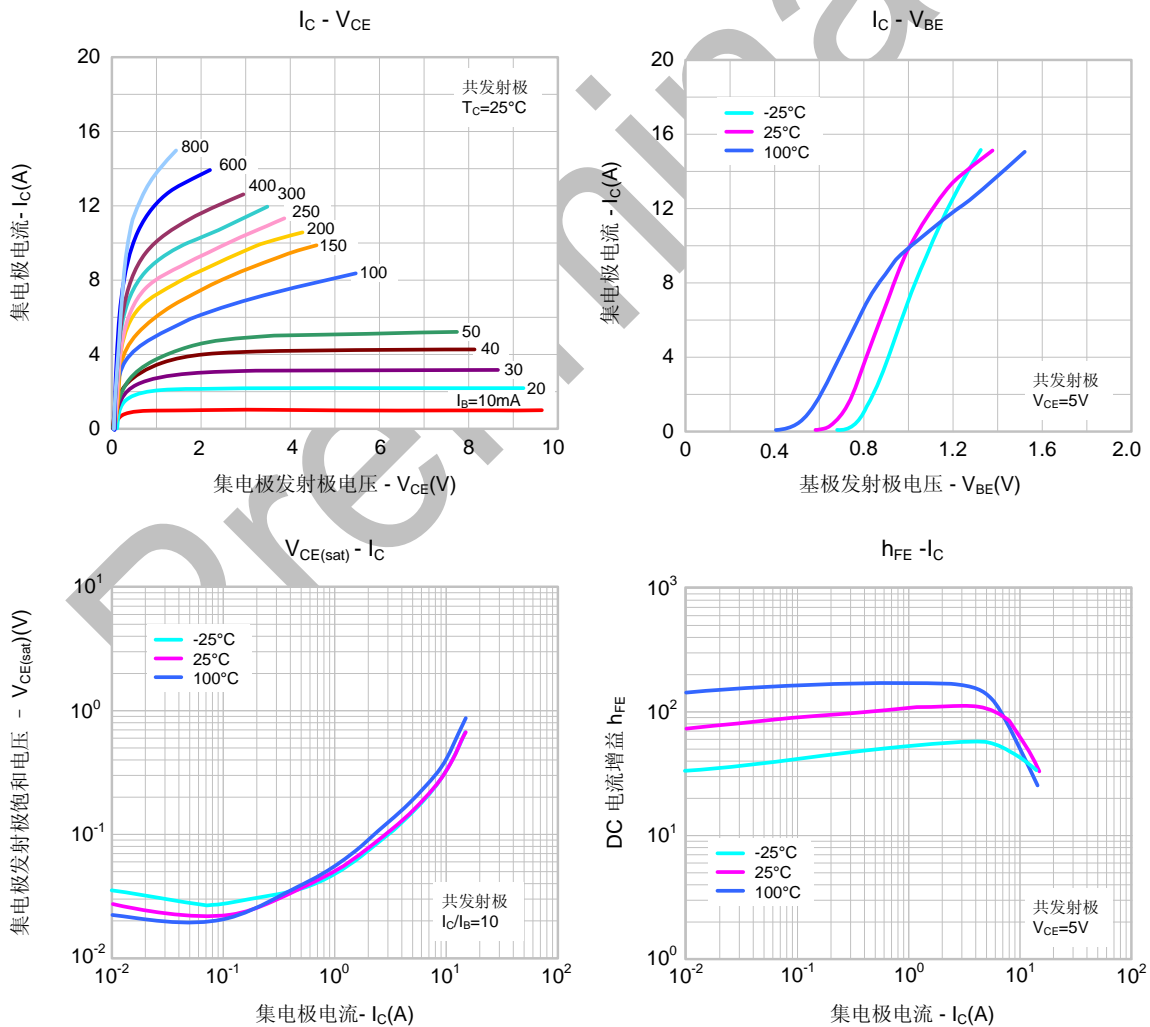
极限参数(除非特殊说明, $T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参 数	符 号	参 数 范 围		单 位
集电极、发射极击穿电压	BV_{CEO}	250	$I_C=5\text{mA}, I_B=0$	V
发射极、基极击穿电压	BV_{EBO}	5	$I_E=1\text{mA}, I_C=0$	V
集电极、基极击穿电压	BV_{CBO}	250	$I_C=1\text{mA}, I_E=0$	V
集电极电流	I_C	15		A
基极电流	I_B	1.5		A
工作结温	T_J	-55~+150		$^{\circ}\text{C}$
存储温度	T_{stg}	-55~+150		$^{\circ}\text{C}$
集电极耗散功率 ($T_c=25^{\circ}\text{C}$)	P_C	150		W

电参数(除非特殊说明, $T_a=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	测试条件	最小值	典型	最大值	单位
直流电流增益	HFE	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=1\text{A}$	A: 70-105			-
		$V_{CE}=5\text{V}, I_C=7\text{A}$	B: 95-130 C: 120-150			-
集电极、发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C=8\text{A}, I_B=0.8\text{A}$	-	0.5	1	V
基极、发射极电压	V_{BE}	$V_{CE}=5\text{V}, I_C=7\text{A}$	-	0.9	1.2	V
集电极、基极漏电流	I_{CBO}	$V_{CE}=250\text{V}, I_B=0$	-	-	10	μA
发射极、基极漏电流	I_{EBO}	$V_{CB}=5\text{V}, I_C=0$	-	-	5	μA
特征频率	f_T	$I_C=-1.0\text{A}, V_{CE}=-5.0\text{V}$ $F_{test}=1.0\text{MHz}$	-	30	-	MHz
集电极输出电容	C_{OB}	$V_{CB}=-10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$	-	370	-	pF

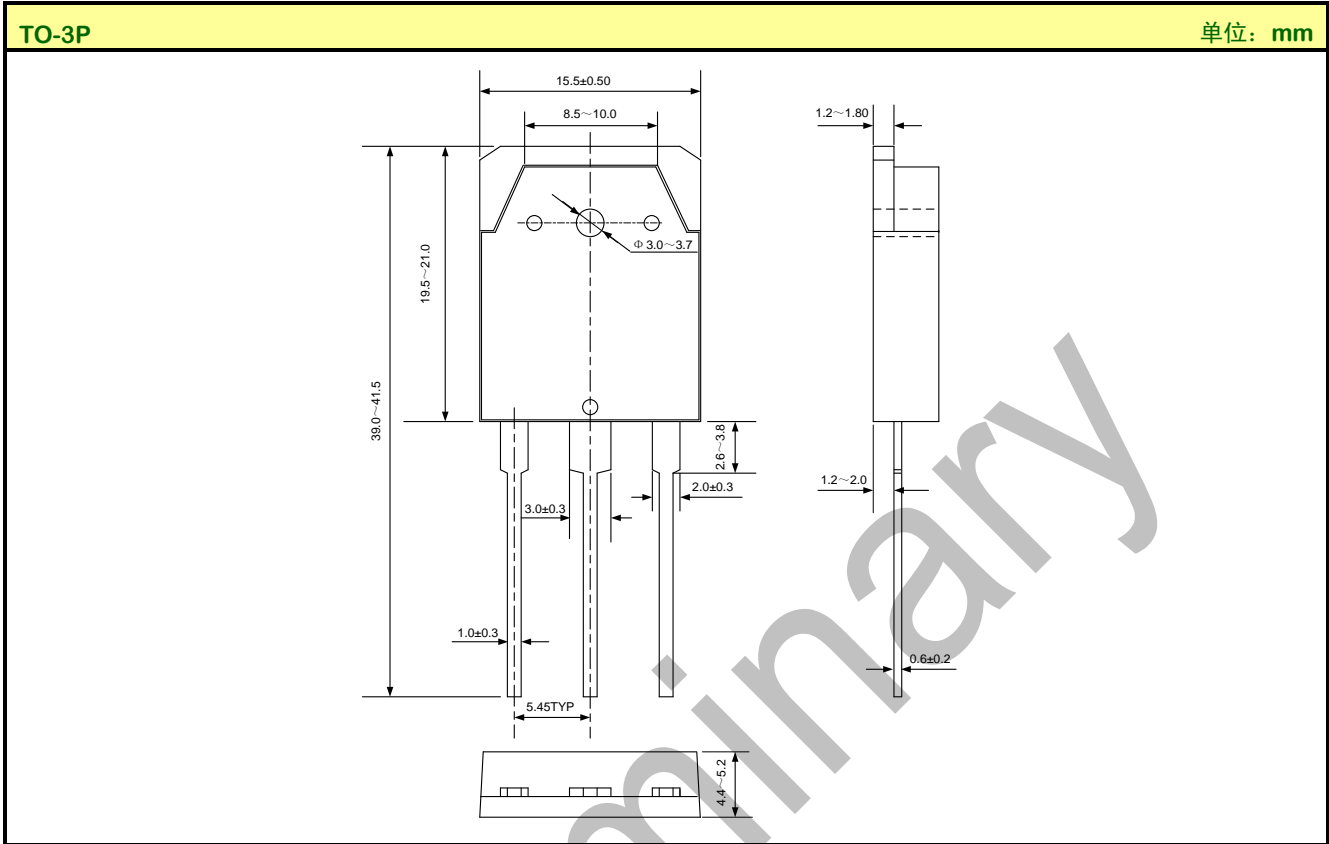
典型特性曲线



封装外形图

TO-3P

单位: mm



声明:

- ◆ 士兰保留说明书的更改权, 恕不另行通知! 客户在下单前应获取最新版本资料, 并验证相关信息是否完整和最新。
- ◆ 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
- ◆ 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

产品名称:	SJT0281NPN	文档类型:	说明书
版 权:	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页:	http://www.silan.com.cn

版 本:	0.2	作 者:	张科锋
------	-----	------	-----

修改记录:

1. 修改电参数

版 本:	0.1	作 者:	张科锋
------	-----	------	-----

修改记录:

1. 初稿
-

Preliminary